

СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВОЇ СИСТЕМИ Ti/Cu

ст. викл. Шпетний І.О., інж. Соломаха В.А.,
маг. Терещенко Ю.І.

Широке використання міді, як найбільш перспективного матеріалу у мікроелектроніці для контактних майданчиків та струмопідвідних доріжок, стає обмеженим внаслідок проявлення інтенсивних процесів дифузії з кремнієм та діелектриками на основі SiO_2 внаслідок дії температурного фактору та електричного поля, що призводить до руйнування пристрій. Різними авторами пропонується використовувати титан у якості дифузійного бар'єру для систем Cu-Si. Діаграма системи Ti-Cu в масивному стані у високотемпературній частині має досить складний характер. Поряд з утворенням твердих розчинів фіксується Cu_4Ti , Cu_2Ti , Cu_3Ti_2 , Cu_4Ti_3 , CuTi , CuTi_2 . У зв'язку з цим інше необхідність у проведенні комплексних досліджень структурно-фазового стану двошарових плівок на основі Ti та Cu у поєднанні з дослідженнями електрофізичних властивостей методом резистометрії. В результаті відпалювання з постійною швидкістю 2-3 К/хв протягом 2-3 циклів „нагрівання-охолодження” спостерігалось збільшення опору зразка після термовідпалювання порівняно зі свіжесконденсованими плівками. До однієї з причин збільшення опору можна віднести утворення високоомних впорядкованих та невпорядкованих твердих розчинів. При даних умовах електронографічно інтерметалеві фази не фіксувалися, хоча авторами [1] при ізотермічному відпалюванні композиції Ti(200нм)/Cu(200нм)/Ti(10нм)/ SiO_2 (370нм)/Si(100нм) протягом одного часу починаючи з $T=870$ К фіксуються інтерметаліди.

1. Фазообразование в пленочной композиции Ti(200нм)/Cu(200нм)/Ti(10нм)/ SiO_2 (370нм) на монокристаллическом кремни (100). / Сидоренко С.И., Ту К.Н., Макогон Ю.Н. и др. // Металлофизика. – 2005. – т.27, № 8. – с. 1017–1025.